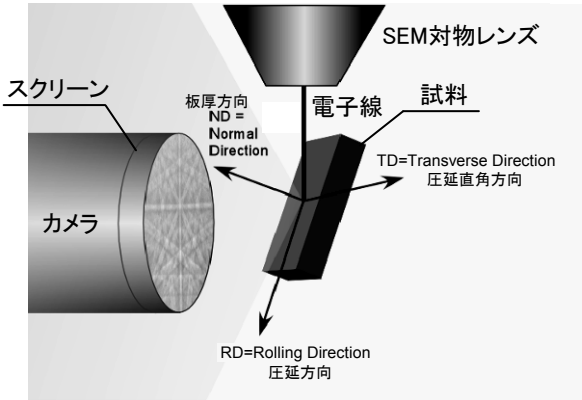




SEM-EBSDによる歪分布評価

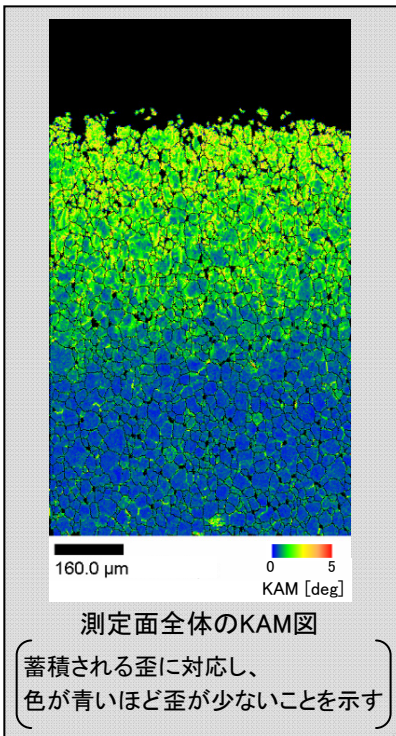
材料内部の歪の分布を評価致します。

EBSD (Electron BackScatter Diffraction)



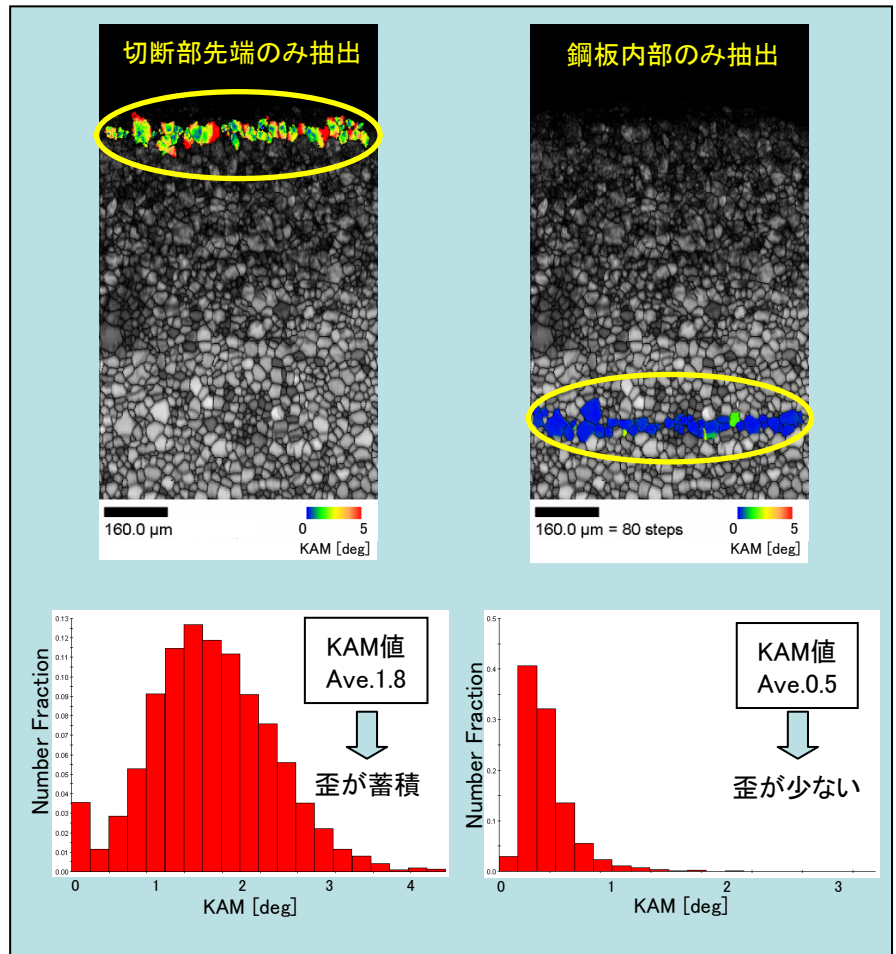
- 金属、半導体、セラミックス等の結晶方位解析には、電子線後方散乱回折像から結晶方位を解析するEBSD測定が利用できます。
- 測定領域全体の結晶方位分布(方位マップ)図が得られ、極点図などの方位プロットや方位情報のグラフ化が可能です。
- さらに、結晶方位差情報から測定試料の加工状況や内部の残留歪などの定量的評価が可能になりました。変形挙動の解析等に有効な情報を提供することができます。

加工による歪発生領域の定量化 (観察例: 極低炭素鋼板のシャー切断部)



- 結晶粒内の歪分布を評価するには、KAM(Kernel Average Misorientation)値が有効です。

※KAM: 測定点とその隣接する全ての測定点間の方位差の平均値。



JFE テクノリサーチ 株式会社

<http://www.jfe-tec.co.jp>

0120-643-777

Copyright ©2011 JFE Techno-Research Corporation. All Rights Reserved. 本資料の無断複製・転載・webサイトへのアップロード等はおやめ下さい。